# 液晶在电场和剪切耦合作用下的流变学行为\*

乔小溪 张向军节 田煜 孟永钢 温诗铸

(清华大学摩擦学国家重点试验室,北京 100084) (2013 年 3 月 27 日收到; 2013 年 5 月 28 日收到修改稿)

本文通过理论和实验对液晶 5CB 在剪切和电场耦合作用下流变行为进行了研究.采用液晶连续理论,建立了包括界面锚定能,弹性自由能,介电自由能和流动能在内的系统 Gibbs 自由能公式,通过最小化系统自由能的方法求解液晶在剪切和电场耦合作用下的取向分布及其黏度变化,从分子基础模型上揭示了液晶在耦合作用下的流变行为、微观机理及其影响规律,并通过流变测试对此进行验证.对比分析了理论和试验结果的误差和原因,发现界面锚定效应对于液晶分子的取向和黏度具有重要影响.理论和试验结果均表明,液晶在电场作用下具有明显的电黏效应,表现出非牛顿流变行为,其黏度值由剪切和电场的竞争和耦合作用共同决定.在外电场作用下液晶的黏度可以增加到初始值的4倍左右,液晶这种其自身黏度可随着外场(例如运动速度)改变的特性在一定的条件下可以自适应地满足不同工况对黏度的要求,这对实现智能摩擦润滑具有重要的意义.

关键词:液晶,流变行为,电黏效应,耦合作用 PACS: 61.30.Dk, 83.85.Cg, 66.20.Ej, 47.65.Gx

## 1引言

自从最早在仿生学的研究中发现液晶的独特 润滑特性以来,液晶以及液晶聚合物的微结构与润 滑性能的研究已经引起广泛的研究兴趣<sup>[1-10]</sup>.液 晶材料是一种处于流体和晶体之间的中间相,既可 以像流体一样流动,同时具有晶体的有序性排列的 性质<sup>[11,12]</sup>.液晶的微结构以及分子取向可以通过 外场控制,比如,电场、磁场和流动场等<sup>[11,13]</sup>.因 而,液晶可望成为一种"智能"润滑材料,实现可控 制的流变与摩擦学性质.

通常优良的润滑介质必须同时具备高的承载 能力和低的剪切阻力<sup>[14]</sup>,而液晶自身取向特性恰 能满足这两种要求.在与运动表面的垂直方向上, 液晶分子的长程有序特性使之呈现固体的抗压性 能,阻止摩擦副表面间的直接接触;在滑动剪切的 方向上,高载荷作用又使其呈现低黏度的流体流动 性,具有较低的剪切阻力.因此液晶作为性能良好 的润滑特性,在各种材质的摩擦副的减摩抗磨中得 到了广泛的应用. 沈明武等<sup>[5]</sup>的研究表明,在纳米

#### DOI: 10.7498/aps.62.176101

级薄膜润滑区添加有液晶的润滑剂薄膜厚度比理 论计算大 3—5 倍. 姚俊兵等 6 指出液晶的减摩作 用根本原因是与液晶分子在边界层的吸附与有序 排列结构有关. 但是人们对液晶的流变行为的智能 控制及其对润滑影响的机理研究还不够. 液晶流变 特性的在线调控对于其在润滑的应用具有重大指 导意义.例如液晶具有特殊的结构、介电各向异性, 在电场的作用下其分子取向会发生改变,进而影响 其黏度的变化;液晶具有明显的电黏效应<sup>[7]</sup>,其黏 度在电场的作用下可以增加到原来的4倍左右.这 些都表明液晶的排列取向和黏度可以通过电场或 剪切速率等对其进行控制.目前,许多研究者通过 理论计算研究了外场对液晶分子取向和表观黏度 的影响<sup>[15-20]</sup>,但是将液晶在耦合外场作用下的分 子取向理论模型的计算与液晶材料的整体流变学 行为的试验结果相结合的研究还比较欠缺,因为这 需要跨越液晶的分子尺度行为与宏观的流变学特 征,同时需要考虑液晶分子在限域空间内受到的固 体壁面的锚定作用、流动剪切作用、电场作用以 及其自身弹性变形能等耦合作用.

\*国家重点基础研究发展计划(批准号: 2012CB934101)、国家自然科学基金(批准号: 50975154, 51175282)资助的课题.

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: xjzhang@mail.tsinghua.edu.cn

本文采用液晶连续理论模型,分析了系统的热 力学 Gibbs 自由能,其中计入了液晶分子的界面锚 定能、弹性变形能、剪切流动动能以及电场下的 介电自由能等,计算研究了电场与剪切耦合作用下, 液晶分子的微观取向分布以及黏度变化规律;并使 用向列相液晶 5CB 作为测试介质,在流变仪上测试 了剪切速率和电场强度对液晶黏度的影响;将理论 与试验进行对比,从分子基础模型上揭示了液晶在 电场和剪切耦合作用下的流变行为、微观机理及 其影响规律.

2 理论部分

#### 2.1 理论模型

本文采用液晶连续体理论<sup>[11,12]</sup>, 计算液晶分 子在电场和剪切作用下的取向分布. 液晶分子的取 向分布与系统的吉布斯自由能有关, 在这种情况下, 其吉布斯自由能主要由锚定能、弹性自由能、介 电自由能、剪切流动能几个部分组成. 当系统的自 由能处于最小状态时, 液晶分子的取向处于平衡状 态. 通过最小化系统在平衡状态下的吉布斯自由能 可以求解得到液晶分子指向矢的分布函数, 进而得 到其黏度变化.



图 1 理论计算的实际模型及其简化示意图

文章中试验部分采用的装置为流变仪, 其核心 测试结构为同心圆筒, 如图 1 左图所示. 在分析液 晶的分子取向行为时, 由于同心圆柱间的距离相对 于转子半径来说很小, 计算中将同心圆筒的间隙简 化为两个平行表面的情况, 如图 1 右图所示. 同心 圆柱两表面间的距离为 h, 上表面 (转子表面)的运 动速度为  $v_0$ , 下表面 (定子表面) 保持不动, 外加电 场的方向垂直于两平行表面如图 1 所示. 建立笛卡 尔坐标系, 将原点选在两表面间的中心平面上, 沿 电场的方向设为 Z 轴的负向, 沿剪切运动的方向设 为 X 轴正向, 这样上下表面在坐标系中的分别位于 z = h/2 和 z = -h/2 处. 理论计算中我们将问题简 化为二维的情况, 假设液晶分子的方位角为零, 其 取向与 xoz 表面平行, 并且在沿着 Y 轴的方向上具 有均一的取向排列结构, 其中 φ 是液晶分子的取向 与 Z 轴方向的夹角. 按照图 1 给出的坐标系, 我们 定义:

易取向: e = (1,0,0);

指向矢:  $n = (\sin \varphi, 0, \cos \varphi);$ 

电场: E = (0, 0, -E).

易取向是指界面处的液晶分子层由于受到界 面锚定作用而具有的特定排列方向,即该层内液晶 分子在仅有界面作用而无其他外场影响时在固体 表面的平均取向.在理论计算中我们采用界面处液 晶分子的易取向与运动表面平行的假设.根据上述 建立的物理模型,我们给出该系统吉布斯自由能的 各分量.

1) 界面处液晶分子的锚定能

$$f_{\rm anch} = \frac{1}{2} A (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{e})^2 = \frac{1}{2} A \sin^2 \varphi_{\pm 2/h}, \qquad (1)$$

其中,A是锚定强度或锚定能系数,e是易取向矢,n 是指向矢,  $\varphi_{+2/h}$  是界面处液晶指向矢与易取向的 夹角. 由于界面作用引起液晶分子定向排列的现象 称为界面锚定. 锚定作用依赖于固体表面的物理化 学性质. 根据液晶分子指向矢 n 偏离易取向 e 难易 程度,可以将锚定分为强锚定和弱锚定.在强锚定 的作用下,液晶分子指向矢 n 与固体表面的易取向 e 取向一致,并且在外场作用下的不易发生改变.在 弱锚定作用下,施加一定的外场作用就可以破坏表 面的分子排列使液晶分子的指向矢 n 偏离易取向 e的方向.通常认为,强锚定时,系统吉布斯自由能 可以忽略界面处锚定能的影响,界面处液晶分子的 指向矢n具有固定取向平行于易取向e.弱锚定时, 表面锚定能不能忽略,系统自由能为表面能和体相 自由能能两部分之和,界面处液晶分子的指向矢 n 会受到外场的影响发生改变而偏离易取向 e. 本文 中在理论计算中采用强的锚定边界条件,即壁面处 的液晶分子取向沿着易取向方向,并且不会随外场 作用 (剪切/电场作用等)而发生改变.

2) 液晶的弹性自由能

$$f_{\text{elas}} = \frac{1}{2} k_{11} (\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2} k_{22} (\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2} k_{33} (\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n})^2.$$
(2)

该公式中的三项分别代表液晶分子展曲,扭转, 弯曲三种变形所产生的能量,其中 k<sub>11</sub>,k<sub>22</sub>,k<sub>33</sub> 分别 代表展曲,扭转和弯曲的弹性系数.针对本文的计 算模型(见图1)有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{n} = -\sin\varphi \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z},$$
$$\nabla \times \boldsymbol{n} = \cos\varphi \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z}\boldsymbol{j},$$
$$\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n} = 0,$$
$$\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n} = \cos\varphi \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z}.$$

于是弹性自由能简化为

$$f_{\text{elas}} = \frac{1}{2} (k_{11} \sin^2 \varphi + k_{33} \cos^2 \varphi) \left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z}\right)^2. \quad (3)$$

由 (3) 式可知, 在本文的电场和剪切的耦合作 用下, 体相液晶分子只有展曲和弯曲两种形变.

3) 液晶的介电自由能

$$f_{\text{elec}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{E}.$$
 (4)

该公式给出了当施加外加电场时,液晶中储存的介电自由能.其中 D 为电位移矢量,且  $D = \varepsilon_{\perp} E + \varepsilon_a (E \cdot n) n$ ,其中,各向异性介电常数  $\varepsilon_a = \varepsilon_{\perp} - \varepsilon_{//}, \varepsilon_{\perp} \approx \varepsilon_{//}$ 分别代表液晶分子垂直和水 平方向上的介电常数,由上述公式可以得到

$$D = \varepsilon_{\perp} E + \varepsilon_a (E \cdot n) n$$
  
=  $(-\varepsilon_a \cos \varphi \sin \varphi E, 0, -\varepsilon_{\perp} E - \varepsilon_a \cos^2 \varphi E),$ 

于是得到液晶的介电自由能为

$$f_{\text{elec}} = -\frac{1}{2} \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{E}$$
$$= -\frac{E^2}{2} (\boldsymbol{\varepsilon}_{\perp} + \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{a}} \cos^2 \boldsymbol{\varphi}). \tag{5}$$

4) 液晶剪切流动动能

$$f_{\text{elec}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{v}_x^2(z), \tag{6}$$

其中,  $\rho$  为液晶材料的密度. 根据图 1, 本文将问题 简化为二维的情况后, 液晶的取向就只在 *xoz* 平面 内转动和移动, 同时, 文中假设剪切流动的速度分 布是线性的, 其速度梯度为常数, 即  $\frac{v_0}{h} = \dot{\gamma} = \text{const},$ 则  $v_x = v_0 \times \left(\frac{z}{h} + 0.5\right).$ 

综上所述,我们可以得到计入了液晶界面锚定 能、弹性自由能、电场作用下的介电自由能以及 剪切引起的流动动能的系统的吉布斯自由能

$$G = \int_{V} (f_{\text{elec}} + f_{\text{flow}} + f_{\text{elas}}) \,\mathrm{d}V + 2Sf_{\text{anch}}, \quad (7)$$

S 为装置上下表面的表面积. 计算中假设液晶的展曲, 扭转和弯曲变形的弹性系数相同, 即

 $k_{11} = k_{22} = k_{33} = k^{[21]}$ ,将 (1), (3), (5), (6) 代入 (7) 式得到

$$G = S \left\{ \int_{z} \left[ -\frac{E^{2}}{2} (\varepsilon_{\perp} + \varepsilon_{a} \cos^{2} \varphi) + \frac{1}{2} \rho \cdot v_{x}^{2}(z) + \frac{1}{2} k \left( \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z} \right)^{2} \right] \mathrm{d}z + A \sin^{2} \varphi_{\pm 2/h} \right\}.$$
(8)

理论计算中采用强锚定边界条件,即认为 近壁面处的液晶分子指向矢 *n* 在电场和剪切 作用下保持不变,且与易取向 *e* 平行,其取向角  $\varphi(\pm h/2) = \pi/2$ ,因此自由能(8)式中第二项非积分 项  $A \sin^2 \varphi_{\pm 2/h}$ 在电场和剪切作用下保持不变,在 最小化系统自由能的计算过程中可以忽略锚定能 的影响.同时固/液界面处采用无滑移边界条件,即  $v(h/2) = v_0, v(-h/2) = 0$ .根据液晶向列相液晶动 力学<sup>[11,12]</sup>,同时由(8)式可以得到

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{2}{\gamma_1} \left( k \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}z^2} - \frac{E^2}{2} \varepsilon_\mathrm{a} \sin 2\varphi \right) + (1 - \lambda) \cos \varphi \frac{\partial v_x}{\partial z}, \tag{9}$$

其中, 速度梯度  $\frac{\partial v_x}{\partial z} = \text{const} = \frac{v_0}{h}, \lambda = \gamma_1/\gamma_2, \gamma_1 = \alpha_3 - \alpha_2, \gamma_2 = \alpha_3 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_6$  是液晶的 Leslie 系数, 该系数与液晶整体的有序度 *S*\*(与温度相关的参量) 有关.

当液晶分子处于平衡状态时,液晶分子的角度 不再发生变化,即 $\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$ .计算中采用无量纲化参数 $z^* = \frac{z}{h}$ ,则 $v_x = v_0 \times (z^* + 0.5)$ ,于是由(9)式得到

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}z^{*2}} - \frac{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{a}E^2h^2}{2k}\sin 2\varphi + \frac{(1-\lambda)\gamma_1v_0h}{2k}\cos\varphi$$
$$=0, \qquad (10)$$

设  $p = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_a(Eh)^2}{2k}, m = \frac{(1-\lambda)h\gamma_1 v_0}{2k},$ 则 (10) 式可以 化简为

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}z^{*2}} - p\sin 2\varphi + m\cos\varphi = 0, \qquad (11)$$

其中, *p*, *m* 分别为与外电场和剪切作用相关的无量 纲数.由(11)式可知, 两者共同耦合作用, 决定了体 相液晶分子的取向倾角 *φ*, 或者说, 除近壁面处液 晶的分子取向由于界面的强锚定作用不发生变化 之外, 体相液晶层中的分子指向矢 *n* 分布是外电场 和剪切作用竞争平衡的结果.

#### 2.2 计算结果与分析

液晶的整体表观黏度取决于其分子的指向矢 *n*倾角与分布<sup>[17]</sup>

$$\eta(\varphi) = \alpha_1 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi + \frac{1}{2} (\alpha_3 + \alpha_6) \sin^2 \varphi + \frac{1}{2} (\alpha_5 - \alpha_2) \cos^2 \varphi + \frac{1}{2} \alpha_4.$$
(12)

计算中使用 5CB 液晶的参数 <sup>[17]</sup>: 液晶的各向 异性介电常数  $\epsilon_a = 10$ , 真空介电常数  $\epsilon_0 = 8.85 \times$  10<sup>-12</sup> (F/m), 弹性常数  $k_{11} = k_{22} = k_{33} = K = 6.2$  pN, 两平行表面的距离 h = 0.7 mm, 在 T = 26 °C 时, 液 晶 5CB 的 Leslie 系数分别为  $\alpha_1 = -0.0060$  Pa·s,  $\alpha_2 = -0.0812$  Pa·s,  $\alpha_3 = -0.0036$  Pa·s,  $\alpha_4 = 0.0652$  Pa·s,  $\alpha_5 = 0.0640$  Pa·s,  $\alpha_6 = -0.0208$  Pa·s,  $\gamma_1 = 0.0777$  Pa·s,  $\gamma_2 = -0.0848$  Pa·s. 根据试验测试 使用的电场强度 E = U/h (U 为施加的电压) 和剪 切速率  $\dot{\gamma} = v_0/h$ , 计算得到的理论分析所需的无量 纲参数 p 和 m, 如表 1, 表 2 所示.

表1 电压对应的无量纲参数 p

电压/V	200	800	1000	1500	1800	2500	2700
无量纲数 p	0.29	4.57	7.14	16.06	23.12	44.61	52.03

表 2	剪切速率对应的无量纲参数 m					
剪切速率/s <sup>-1</sup>	229	412	774	1000		
无量纲数 m	1.34	2.42	4.55	5.88		

通过 Mathmatica 软件求解 (11) 式得到在电场 和剪切耦合作用下,平行板间的液晶分子的指向 矢n分布的数值解,如图2和图3所示.其中,横 坐标是无量纲量 Z\*,即剪切两表面间隙内的相对 位置,零点位置代表剪切间隙的中心面位置.坐标  $Z^* = \pm 0.5$ 代表固/液界面的位置. 纵坐标是液晶分 子的取向角度  $\varphi$ ,在固液界面处,液晶分子的取向 角度为90°(即,沿着易取向 e 平行于壁面而排列). 图 2 给出了在外电场无量纲数 p = 7.14 时,液晶分 子取向角度分布随着剪切无量纲数 m 值变化的情 况. 由图 2 可以看出, 电场强度不变的情况下, 剪 切速率越大,体相内液晶分子越趋向平行于固体壁 面排列.图3给出了剪切无量纲数m=4.55时,液 晶分子取向随着电场无量纲数 p 值的变化情况, 由 图 3 所示, 在剪切速率不变时, 电场强度越大液晶 分子越趋向于垂直于壁面排列,并且当无量纲数 p 增加到一定值时,随着 p 的增加液晶分子的取向基 本不发生变化. 综上所述, 剪切作用使液晶分子趋 于平行壁面排列 (剪切运动方向), 而外电场作用使 液晶分子趋于垂直于壁面排列 (沿着电场方向). 液 晶分子的取向分布由剪切作用和电场两者共同耦 合决定.



图 2 p=7.14 时,液晶取向角度分布曲线随 m 值的变化





通过求解得到的角度分布,由 (12) 式计算可以进一步得到液晶的黏度分布,并进行积分  $\eta_a = \int_{-0.5}^{0.5} \eta(\varphi, z) dz$ 得到其整体表观黏度,如图 4 和图 5 所示.图 4 给出在不同的剪切无量纲数 *m* 值 时, 表观黏度随着电场无量纲数 p 的变化, 计算结 果显示,液晶存在明显的电黏效应,其黏度值可增 加原来的4倍左右;随着电场强度的加强,液晶的 表观黏度不断增加;不同剪切速率下,表观黏度在 电场作用下所达到的最大值趋于相同,这是因为当 电场作用足够大时,体相液晶分子取向已经趋于稳 定值,随着电场强度的进一步增加液晶分子的取向 基本保持不变;同时,液晶黏度的改变存在临界电 压值,该临界值的大小与剪切速率有关,剪切速率 越大,临界值越大,当电压值小于该值时液晶黏度 基本不变.当电压大于该临界电压时,液晶的分子 取向发生较快的变化 (如图 3 所示), 其黏度迅速增 加.图5给出了不同电场无量纲数 p 值时, 表观黏 度随着剪切无量纲数 m 的变化情况. 由图 5 可以看 出: 1) 在 p = 0.29 和 p = 4.57 时, 剪切无量纲数 m 的变化对表观黏度没有影响,即在小的电场强度下, 剪切速率的变化对液晶分子的取向基本没有影响. 是因为即使在较弱的剪切作用下,该电场强度也不 足以改变液晶分子在剪切作用下的初始取向,所以 随着剪切速率的增加液晶分子的取向不发生变化 始终沿着剪切的方向. 2) 在 p > 7.14 时, 随着剪切 无量纲数 m 的增加, 表观黏度逐渐减小, 即在一定 的电场强度下,剪切速率越大表观黏度越小,表现 出一定程度的剪切稀化现象.是因为在电场作用不 变的情况下,剪切速率越大液晶分子越趋向于沿着 剪切方向排列导致运动阻力降低,表观黏度减小. 3) p = 7.14 时, 当 m < 4.55 时, 随着 m 增加, 表观黏 度逐渐减小;当 m≥4.55 时,表观黏度不再变化. 说 明在小的剪切速率作用下,电场强度还足以影响液 晶分子趋于电场方向排列,当剪切速率足够大时, 该电场强度将不足以引起液晶分子的取向改变.综 上所述,液晶的黏度是剪切作用和电场强度竞争和 耦合作用的结果. 电压越大, 其表观黏度越大; 剪切 速率越大,其表观黏度越小,

3 试验部分

### 3.1 试验材料与仪器

试验测试使用的材料是小分子向列相液晶 5CB (4- 氰基 -4'- 戊基联苯),其分子排列方式和结 构如图 6(a) 和 (b) 所示. 5CB 熔点为 22 °C,清亮点 为 35.3 °C,在该温度范围内 5CB 处于其液晶态,其 液晶相密度为 1.008 g/cm<sup>3</sup>.5CB 液晶分子具有正的 各向异性,在电场的作用下会沿与电场方向进行 排列<sup>[7]</sup>. 试验采用 Physica MCR301 流变仪 (Anton Paar 公司) 装置对不同剪切速率和电场强度下的液体黏度进行测试,试验中采用同轴圆筒式转子测量 附件如图 6(c) 所示. 其中, 同轴圆筒间的距离 *d* 约为 0.7 mm.



图 4 不同的 m 值时, 表观黏度随 p 值变化的曲线



图 5 不同的 p 值时, 表观黏度随 m 值变化的曲线



图 6 (a) 向列相液晶分子排列方式; (b) 5CB 液晶分子结构; (c) 试验装置示意图

### 3.2 试验结果与分析

试验测试了液晶 5CB 在不同的电压和剪切速 率耦合作用下的黏度,所有的试验测试温度均为 26°C,在该温度下,5CB 处于向列相液晶态.试验 结果如图 7 和图 8 所示.



图 7 不同剪切速率下,液晶 5CB 黏度随电压变化的曲线



图 8 不同电场强度下,液晶 5CB 黏度随剪切速率变化的曲线

图7给出了不同剪切速率下,液晶黏度随着电 压变化的曲线. 图 7 表明, 液晶存在明显的电黏效 应,其黏度值在电场作用下可增加到初始值的4倍 左右. 在相同的剪切速率下, 液晶的黏度随着电压 的升高逐渐的增加,最后趋于一个稳定值;不同的 剪切速率下,液晶黏度所达到的稳定值基本相同, 并且剪切速率越小,液晶黏度达到稳定值的所需的 外加电场强度越小.图8给出不同的电压下,液晶 的黏度随着剪切速率变化的曲线. 该图表明, 在仅 有剪切作用(电压为0V)的情况下,液晶黏度与剪 切速率无关,表现出牛顿流体性质;随着电压的增 加,液晶的黏度开始随着剪切速率增加而降低,呈 现一定的剪切稀化现象,表现出非牛顿体的流变行 为;当电压足够大时,其黏度随着剪切速率增加也 基本不发生改变,如图 8 给出的电场为 2700 V 的 黏度曲线.

4 分析与讨论

液晶的黏度主要取决于其分子的取向和有序

度,液晶存在三种特征黏度系数,称为 Miesowicz 黏度,如图 9 所示的  $\eta_c > \eta_a > \eta_b$ ,分别代表了液晶分子长轴沿着速度方向和速度梯度方向取向的三种特殊排列<sup>[22]</sup>.由于液晶其自身特殊的性质和结构使其能够通过电场和剪切作用发生取向改变.



图 9 在一定剪切速率下,液晶分子的取向随着电场强度变化的情况

由计算结果图 2 和图 3 可以看出: 电场具有使 液晶分子 (对于正的各向异性的液晶而言) 趋向沿 着电场方向 (垂直于运动方向) 排列的作用; 而剪 切作用使液晶分子趋向于沿着运动方向(垂直于电 场) 排列. 不同电场强度和剪切速率组合得到的分 子取向和黏度不同,如图4,图5,图7和图8所示. 液晶的黏度是电场和剪切作用相互耦合和竞争的 结果. 如图 9 所示, 在剪切速率一定的情况下, 当电 压很小时,基本对其分子取向没有影响,随着电场 强度的逐渐增加,液晶分子的取向不断发生变化, 当电场强度足够大时,液晶分子基本沿着电场方向 取向.液晶沿着与运动垂直的方向排列具有较大的 运动阻力,而沿着流场运动的方向排列有利于降低 其阻力,因此液晶的黏度随着电压的增加而增加; 随着剪切速率增加而降低,如图4,图5,图7和图8 所示.

在理论计算中,均采用了与试验相同的条件进 行模拟.将理论与试验结果进行对比可以看出两者 在趋势具有很好的一致性.但是两者在数值上存在 着一定的误差,如图 10 所示.这是因为在计算中认 为液晶分子取向排列为理想状态,但实际试验测试 中液晶分子不可能完全理想取向分布,而是具有有 限的有序度 *S\**,并且在计算中采用了强锚定的边界 条件,认为界面处的液晶分子取向不发生改变.表 面的锚定强度对于系统内液晶分子取向角度以及 系统转向阈值电压都具有重要的影响,一般来说强 锚定的表面相对弱锚定的表面具有较高的阈值电 压.图 4 和图 7 结果可以看出计算结果相对试验具 有较高的阈值电压,并且临界电压随着剪切速率增 加而增加,而试验得到的阈值电压非常小,同时计 算得到的黏度远小于试验值,这可能是由于我们采 用的边界条件所引起误差.由于边界强锚定的存在 使得壁面液晶分子始终平行于表面,进而影响体相 的液晶分子的取向,使液晶分子整体趋向于平行于 壁面排列而导致液晶的黏度降低.

因此我们考虑界面锚定为弱锚定情况下液晶 在电场和剪切耦合作用下的黏度.弱锚定情况下界 面处的液晶分子的取向角度会随着电场强度的变 化而发生改变.如图 10 所示,我们给出了在不同的 界面液晶分子取向角对表观黏度变化影响.可以看 出界面处液晶分子取向对整体的黏度影响很大.但 在计算过程中,针对每条曲线在不同的电压的情况 下计算均采用了相同的边界取向角度,而实际弱锚 定情况下,该取向角会随着电场强度增加从 90° 逐 渐趋近于 0° (垂直于表面).由上述讨论我们可以看 出界面处的锚定强弱对于液晶的黏度具有重要的 影响.



图 10 剪切速率为 412 s<sup>-1</sup> (*m* = 2.42) 时, 理论 (不同锚定角度) 与试验结果的对比图

为进一步分析界面锚定作用对液晶的体相黏 度的影响比重,因此我们考虑忽略界面锚定的影响 (或者说界面锚定作用非常弱), 使系统整体的液晶 分子在电场和剪切作用下都具有一致相同的取向, 于是理论公式 (11) 中的第一项  $\frac{d^2\varphi}{dz^{*2}}$ = 0, 并且得到 不同场强耦合作用下的取向计算公式  $\sin \varphi = m/2p$ . 由此我们可以得到在忽略界面锚定作用时,液晶的 黏度随着剪切速率和电场强度变化的取向,并与实 验结果进行对比如图 11 所示. 发现在不考虑壁面 锚定作用影响时,理论计算和实验结果具有在趋 势和数值上都有相对较好的符合.在电压较高情况 下,试验值和计算值基本相同,但是在黏度上升阶 段两者仍具有一定的误差.为进一步分析该误差的 原因,我们将不同电场和剪切速率下黏度进行归一 化处理,由公式  $\sin \varphi = m/2p = \frac{(1-\lambda)\gamma_1}{2\epsilon_0\epsilon_a}\frac{\dot{\gamma}}{E^2}$ 可知. 表观黏度在耦合作用下主要与影响因子  $\frac{\dot{\gamma}}{E^2}$  相关, 因此我们以  $\frac{\dot{\gamma}E_{ref}^2}{E^2}$  (其中  $E_{ref} = 285.7$  V/mm) 作为横 坐标对理论和试验数据进行处理,结果如图 12 所 示. 由图 12 可以看出在  $\frac{\dot{\gamma}E_{ref}^2}{E^2}$  较小时计算和实验 具有非常好的符合. 但是在  $\frac{\dot{\gamma}E_{ref}^2}{E^2}$  较大时两者仍具 有一定的差值. 当  $\frac{\dot{\gamma}E_{ref}^2}{E^2}$  足够大时,此时电场的作用 基本可以忽略,由理论公式  $\sin \varphi = m/2p$  可知,此 时液晶的取向角为 90°,液晶分子平行于表面排列, 于是得到液晶的计算黏度为 20.4 mPa·s ( $\eta_b$ )、但在 无电场作用下其测试黏度为 24.7 mPa·s,此误差可 能是由于分子实际排列和有序度与理论计算的差 别引起的. 计算结果是按照液晶分子具有统一的 指向矢且平行于界面排列 (如图 9 所示的  $\eta_b$  的排 列方式) 得到的结果,但是实际测量中,液晶分子 并不具有理想排列方式且存在一定的有序度,即 使平行于表面排列也可能同时具有如图 9 所示  $\eta_a$ 



图 11 不考虑锚定效应时,理论计算与试验结果的对比



图 12 不考虑锚定效应时,理论计算与试验结果的归一化曲线

和 η<sub>b</sub> 两种排列方式.随着电场强度的增加,液晶 分子逐渐向垂直方向转动,此时液晶分子的取向角 仍具有一定分散性,并不具有理论计算的均匀单 一的取向.只有当电场强度足够大时,液晶分子完 全垂直取向,此时仅有单一取向方向与计算情况比 较接近.

## 5 结 论

本文建立了液晶在电场与剪切耦合作用下的 系统热力学 Gibbs 自由能的计算模型,理论分析了 液晶分子在外场作用下的取向分布和黏度变化,并 通过试验进行验证,两者结果具有很好的一致性, 可以用于指导液晶表观黏度的控制.

理论和实验结果均表明,在相同剪切速率下,

- Iglesias P, Bermudez M D, Carrion F J, Martinez-Nicolas G 2004 Wear 256 386
- [2] Zhang C L, Zhang S M, Yu L G, Zhang P Y, Zhang Z J, Wu Z S 2012 Tribology Letters 1 49
- [3] Ge L L, Chen L P, Guo R 2007 Tribology Letters 2 123
- [4] Morishita S, Matsumura Y, Shiraishi T 2002 Journal of Japanese Society of Tribologists 11 846
- [5] Shen M W, Luo J B, Wen S Z, Yao J B 2001 Chinese Science Bulletin
  7 603 (in Chinese) [沈明武, 雒建斌, 温诗铸, 姚俊斌 2001 科学通报
  7 603]
- [6] Yao J B, Wen S Z, Wang Q L, Chen S Q, Xu M 2000 Lubrication Engineering 3 24 (in Chinese) [姚俊兵, 温诗铸, 王清亮, 陈声强, 徐敏 2000 润滑与密封 3 24]
- [7] Zhang X J, Zhang X H, Xiong Y, Tian Y, Wen S Z 2012 Rheologica Acta 3 267
- [8] Amann T, Dold C, Kailer A 2012 Soft Matter 38 9840
- [9] Nakano K 2004 Journal of Japanese Society of Society of Tribologists 1 36
- [10] Shen M W, Luo J B, Wen S Z, Yao J B 2002 Lubrication Engineering 3 18
- [11] de Gennes P G, Prost J 1993 The Physics of Liquid Crystals (New

液晶的黏度随着电场的强度增加而增加,并最终达 到一个稳定值;在不同剪切速率下,黏度所达到的 稳定值基本相同;剪切速率越小,液晶黏度达到稳 定值的所需外加电场强度越小;在同一电压值下, 剪切速率越大,液晶黏度越小.液晶黏度是由剪切 与电场的竞争与耦合作用共同决定的,并对理论和 试验结果误差进行分析,发现界面的锚定作用对液 晶分子取向和黏度具有重要的影响.

液晶黏度的可控性,及其在电场作用下黏度值 增加到原来4倍左右(如图7所示)的性质对于利 用液晶作为智能润滑材料的研究领域具有重要的 意义.在实际的工况条件下,不同运动条件对润滑 剂的黏度要求不同,液晶这种其自身黏度可随着运 动速度改变的特性在一定的条件下可以自适应满 足其工况对黏度的要求.

York: Oxford University Press)

- [12] Xie Y Z 1988 Physics of Liquid Crystal (Beijing: Science Press)(in Chinese) [谢毓章 1988 液晶物理学(北京:科学出版社)]
- [13] Pasechnik S V, Chigrinov V G, Shmeliova D V 2009 Liquid Crystals: Viscous and Elastic properties (Weinheim: Wiley-VCH)
- [14] Wen S Z, Huang P 2008 Principles of Tribology (3rd Ed) (Beijing: Tsinghua University Press) (in Chinese) [温诗铸, 黄平 2008 摩擦学原 理 (北京: 清华大学出版社)]
- [15] Medina J C, Mendoza C I 2008 Europhysics Letters 84 160021
- [16] Negita K 1996 Journal of Chemical Physics 17 7837
- [17] Reyes J A, Corella M A, Mendoza C I 2008 Journal of Chemical Physics 129 0847108
- [18] Reyes J A, Manero O, Rodriguez R F 2001 Rheologica Acta 5 426
- [19] Guillen A D, Mendoza C I 2007 Journal of Chemical Physics 126 204905
- [20] He S L, Wang Q 2001Acta Phys. Sin. 50 926 (in Chinese) [何赛灵, 王 谦 2001 物理学报 50 926]
- [21] Matthias H, Roder T, Wehrspohn R B, Kitzerow H S, Matthias S, Picken S J 2005 Appl. Phys. Lett. 87 24110524
- [22] Miesowicz M 1946 Nature 158 27

# Study the coupling effect of shear and electric field on rheological behaviors of liquid crystals\*

Qiao Xiao-Xi Zhang Xiang-Jun<sup>†</sup> Tian Yu Meng Yong-Gang Wen Shi-Zhu

(State Key of Laboratory Tribology, Tisnghua University, Beijing 100084, China) (Received 27 March 2013; revised manuscript received 28 May 2013)

#### Abstract

The rheological behaviors of 5CB liquid crystal under the coupling effect of shear and electric field are investigated by theoretical and experimental study. Establish calculating equation of the system Gibbs free energy by adopting the continuum theory of liquid crystals which contains anchoring energy, elastic free energy, dielectric free energy and flow energy. Then the molecular orientation angle distribution and apparent viscosity of liquid crystal under the coupling effect are obtained by minimizing the Gibbs free energy, revealing the microscopic mechanism of rheological behaviors and influence rules of coupling effect from the molecular model. Meanwhile the calculated results are verified by rheological test. Comparative Analysis of the errors and reasons of theoretical and experimental results, which demonstrates that anchoring effect plays an important role in the molecular orientation and viscosity of liquid crystal. Both the theoretical and experimental results indicate that liquid crystals have electroviscous effect and behavior like non- Newtonian liquids under electric field. The viscosities of liquid crystals are determined by the coupling and competition action of shear and electric field, which can reach 4 times of its original value under electric field. This property of controllable viscosity is important in tribology, which can self-adaptively satisfy the requirement of viscosities for different working conditions as a "smart lubrication" under certain condition.

Keywords: liquid crystals, rheological behavior, electric-viscous effect, coupling field

**PACS:** 61.30.Dk, 83.85.Cg, 66.20.Ej, 47.65.Gx

DOI: 10.7498/aps.62.176101

<sup>\*</sup> Project supported by the National Basic Research Program of China (973) (Grant No. 2012CB934101), and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50975154, 51175282).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: xjzhang@mail.tsinghua.edu.cn